

# 2SB1640

シリコンPNP三重拡散形

(2SB1640)

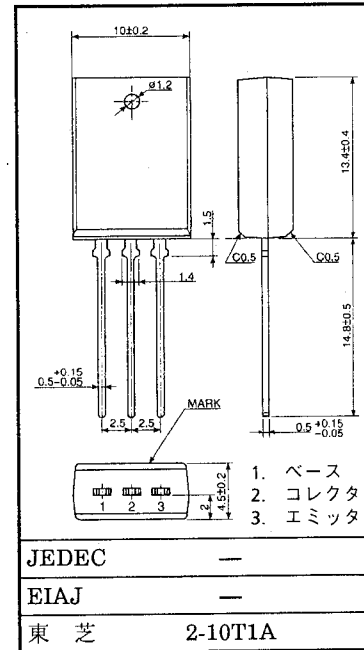
○ 低周波電力増幅用

- 飽和電圧が低い。  
:  $V_{CE(sat)} = -1.5V$  (最大) ( $I_C = -2A, I_B = -0.2A$ )
- 2SD2525とコンプリメンタリになります。

最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-60	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-7	V
コレクタ電流	DC	$I_C$	-3
	パルス	$I_{CP}$	-6
ベース電流	$I_B$	-0.5	A
コレクタ損失	PC	1.8	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$

単位: mm



電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -60V, I_E = 0$	—	—	-10	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -7V, I_C = 0$	—	—	-10	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -50mA, I_B = 0$	-60	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	100	—	320	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -2A$	15	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -2A, I_B = -0.2A$	—	-1.0	-1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	—	-0.75	-1.0	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	—	9	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	50	—	pF